

2
11-15-00
ca.

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of

IZUMI et al

Atty. Ref.: 1035-240

Serial No. to be assigned

Group: unknown

Filed: December 13, 1999

Examiner: unknown

For: TWO-DIMENSIONAL IMAGE DETECTING
DEVICE AND MANUFACTURING METHOD
THEREOF

* * * * *

Honorable Assistant Commissioner of Patents
Washington, DC 20231



SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Sir:

It is respectfully requested that this application be given the benefit of the foreign filing date under the provisions of 35 U.S.C. §119 of the following, a certified copy of which is submitted herewith:

<u>Application No.</u>	<u>Country of Origin</u>	<u>Filed</u>
10-355119	Japan	14 December 1998
11-252227	Japan	6 September 1999

Respectfully submitted,
NIXON & VANDERHYE P.C.

December 13, 1999

By: *H. Warren Burnam, Jr.*
H. Warren Burnam, Jr.
Reg. No. 29,366

HWB:lsh
1100 North Glebe Road, 8th Floor
Arlington, VA 22201-4714
Telephone: (703) 816-4000
Facsimile: (703) 816-4100

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1 9 9 8 年 1 2 月 1 4 日

出 願 番 号
Application Number:

平成 1 0 年 特 許 願 第 3 5 5 1 1 9 号

出 願 人
Applicant (s):

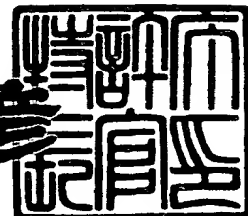
シャープ株式会社



1 9 9 9 年 9 月 1 7 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

近 藤 隆 彦



出 証 番 号 出 証 特 平 1 1 - 3 0 6 3 9 8 3

【書類名】 特許願

【整理番号】 98-02086

【提出日】 平成10年12月14日

【あて先】 特許庁長官 伊佐山 建志 殿

【国際特許分類】 H01L 27/14
H01L 31/00

【発明の名称】 二次元画像検出器およびその製造方法

【請求項の数】 8

【発明者】
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
【氏名】 和泉 良弘

【発明者】
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
【氏名】 寺沼 修

【特許出願人】
【識別番号】 000005049
【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】
【識別番号】 100080034
【弁理士】
【氏名又は名称】 原 謙三
【電話番号】 06-351-4384

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 003229
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1

特平 10-355119

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9003082

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 二次元画像検出器およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

格子状に配列された電極配線と、各格子点ごとに設けられた複数のスイッチング素子と、該スイッチング素子を介して該電極配線に接続される画素電極とからなる画素配列層を含むアクティブマトリクス基板と、

該画素配列層のほぼ全面に対向して形成される電極部と、該画素配列層および該電極部の間に形成される光導電性を有する半導体層とを含む対向基板とを備えており、

これら両基板が、該アクティブマトリクス基板の画素配列層と、該対向基板の半導体層とが対向するように配置されるとともに、該画素電極に対応してパターン形成された導電性および接着性を有する導電接続材によって接続されており、

さらに、これら両基板の間隙に、両基板の間隔を保持する間隔保持材がパターン形成されていることを特徴とする二次元画像検出器。

【請求項 2】

上記間隔保持材は、上記導電接続材を囲むように格子状に形成されていることを特徴とする請求項 1 記載の二次元画像検出器。

【請求項 3】

上記間隔保持材は、電気絶縁性を有する材料によって形成されていることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の二次元画像検出器。

【請求項 4】

上記間隔保持材は、上記導電接続材の接続工程の熱圧着環境下において、該導電接続材より高い硬度を有するように設定されていることを特徴とする請求項 1 から 3 の何れかに記載の二次元画像検出器。

【請求項 5】

上記間隔保持材は、ポリイミド高分子材料よりなっていることを特徴とする請求項 1 から 4 の何れかに記載の二次元画像検出器。

【請求項 6】

上記間隔保持材は、電気絶縁性を有する液状の樹脂材料中に、上記導電接続材の接続工程の熱圧着環境下での変形量が小さく、電気絶縁性を有する補助材が混入されたものであることを特徴とする請求項 1 から 5 の何れかに記載の二次元画像検出器。

【請求項 7】

格子状に配列された電極配線と、各格子点ごとに設けられた複数のスイッチング素子と、該スイッチング素子を介して該電極配線に接続される画素電極とからなる画素配列層を含むアクティブマトリクス基板、および、該画素配列層のほぼ全面に対向して形成される電極部と、該画素配列層および該電極部の間に形成される光導電性を有する半導体層とを含む対向基板のうち、どちらか一方の基板上に、該画素電極に対応して導電性および接着性を有する導電接続材をパターン形成する第一の工程と、

他方の基板上に、電気絶縁性を有し、両基板の間隔を保持する間隔保持材を該導電接続材を囲むように格子状にパターン形成する第二の工程と、

両基板を、該アクティブマトリクス基板の画素配列層と、該対向基板の半導体層とが対向するように配置する第三の工程と、

両基板を、該導電接続材を介して接続して貼り合わせる第四の工程とを含んでいることを特徴とする二次元画像検出器の製造方法。

【請求項 8】

上記の第一および第二の工程では、上記の導電接続材および間隔保持材を、上記のアクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせ前における高さが該間隔保持材よりも該導電接続材の方が大きくなるようにパターン形成することを特徴とする請求項 7 記載の二次元画像検出器の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、X線等の放射線、可視光、赤外光等の画像を検出できる二次元画像検出器、およびその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来より、放射線の二次元画像検出器として、X線を感知して電荷（電子-正孔）を発生する半導体センサを二次元状に配置し、これらのセンサにそれぞれ電気スイッチを設けて、各行ごとに電気スイッチを順次オンにして各列ごとにセンサの電荷を読み出すものが知られている。

【0003】

このような放射線二次元画像検出器については、「D.L.Lee,et al., “A New Digital Detector for Projection Radiography”,Proc.SPIE,Vol.2432,Physics of Medical Imaging,pp.237-249,1995」、「L.S.Jeromin,et al., “Application of a-Si Active-Matrix Technology in a X-Ray Detector Panel”,SID(Society for Information Display) International Symposium,Digest of Technical Papers,pp.91-94,1997」、および特開平6-342098号公報等の文献に、具体的な構造や原理が記載されている。

【0004】

以下、図10および図11を用いて、上記従来の放射線二次元画像検出器の構成および原理について説明する。図10は、上記放射線二次元画像検出器の構造を模式的に示した斜視図である。図11は、1画素当たりの構成を模式的に示した断面図である。

【0005】

図10および図11に示すように、上記放射線二次元画像検出器は、ガラス基板51上にXYマトリクス状の電極配線（ゲート電極52およびソース電極53）、TFT（薄膜トランジスタ）54、電荷蓄積容量（Cs）55等が形成されたアクティブマトリクス基板50を備えている。また、上記アクティブマトリクス基板50上には、そのほぼ全面に、光導電膜56、誘電体層57および上部電極58が形成されている。

【0006】

上記電荷蓄積容量55は、Cs電極59と、上記TFT54のドレイン電極に接続された画素電極60とが、絶縁膜61を介して対向している構成である。

【0007】

上記光導電膜56は、X線等の放射線が照射されることで電荷が発生する半導体材料が用いられる。上記の文献では、光導電膜56として、暗抵抗が高く、X線照射に対して良好な光導電特性を示すアモルファスセレン(a-Se)が用いられている。そして、上記光導電膜56は、真空蒸着法によって300~600 μ mの厚みで形成されている。

【0008】

また、上記アクティブマトリクス基板50は、液晶表示装置を製造する過程で形成されるアクティブマトリクス基板を流用することが可能である。例えば、アクティブマトリクス型液晶表示装置(AMLCD)に用いられるアクティブマトリクス基板は、アモルファスシリコン(a-Si)やポリシリコン(p-Si)によって形成されたTFTや、XYマトリクス電極、電荷蓄積容量を備えた構造になっている。したがって、若干の設計変更を行うだけで、放射線二次元画像検出器用のアクティブマトリクス基板50として容易に利用することができる。

【0009】

つぎに、図10および図11を用いて、上記構造の放射線二次元画像検出器の動作原理について説明する。まず、上記光導電膜56に放射線が照射されると、光導電膜56内に電荷が発生する。光導電膜56と電荷蓄積容量55とは電氣的に直列に接続された構造になっているので、上部電極58とCs電極59との間に電圧を印加しておく、光導電膜56で発生した電荷がそれぞれ+電極側と-電極側とに移動し、その結果、電荷蓄積容量55に電荷が蓄積される。なお、光導電膜56と電荷蓄積容量55との間には、薄い絶縁層からなる電子阻止層62が形成されており、これが一方側からの電荷の注入を阻止する阻止型フォトダイオードの役割を果たしている。

【0010】

上記の作用で、電荷蓄積容量55に蓄積された電荷は、ゲート電極G1、G2、…、Gnの入力信号によりTFT54をオープン状態にすることによって、ソース電極S1、S2、…、Snから外部に取り出すことができる。よって、ゲート電極52およびソース電極53、TFT54、および電荷蓄積容量55等は、

すべてXYマトリクス状に設けられているため、ゲート電極G1、G2、…、G_nに入力する信号を線順次に走査することで、二次元的にX線の画像情報を得ることが可能となる。

【0011】

なお、上記放射線二次元画像検出器は、使用する光導電膜56がX線等の放射線に対する光導電性だけでなく、可視光や赤外光に対しても光導電性を示す場合は、可視光や赤外光の二次元画像検出器としても作用する。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】

上記従来 of 構造の放射線二次元画像検出器では、光導電膜56としてa-Seを用いている。しかしながら、a-SeはX線に対する応答性が十分でないことから、X線を長時間照射して電荷蓄積容量55を十分に充電してからでないとい情報を読み出すことができず、また、X線照射を遮断後、光導電膜56が初期状態に戻るのに時間を要する、という欠点がある。

【0013】

また、上記放射線二次元画像検出器では、高電圧保護やリーク電流（暗電流）の低減を目的として、a-Seの光導電膜56と上部電極58との間に誘電体層57が設けられている。しかしながら、誘電体層57に残留する電荷を1フレームごとに除去する工程（シーケンス）を付加する必要があるため、上記放射線二次元画像検出器は、静止画の撮影にしか利用することができないという問題を有していた。

【0014】

これに対し、動画に対応した画像データを得るためには、X線に対する応答性、感度の優れた光導電膜56を利用する必要がある。このような光導電材料としては、Seに比べて実効原子番号が大きいCdTeやCdZnTe等が知られている。ところが、上記放射線二次元画像検出器の光導電膜56として、a-Seの代わりにCdTeやCdZnTeを利用しようとすると、以下のような問題が生じる。

【0015】

従来の a-Se の場合、成膜方法として真空蒸着法を用いることができ、この時の成膜温度は常温で可能なため、上述のアクティブマトリクス基板 50 上への成膜が容易であった。これに対し、CdTe や CdZnTe の場合は、MBE (molecular beam epitaxy) 法や MOCVD (metal organic chemical vapor deposition) 法による成膜法が知られており、特に大面積基板への成膜を考慮すると MOCVD 法が適した方法と考えられる。しかしながら、MOCVD 法で CdTe や CdZnTe を成膜する場合、約 400℃ の高温が要求される。

【0016】

一般に、アクティブマトリクス基板 50 に形成されている前述の TFT 54 は、半導体層として a-Si 膜や p-Si 膜を用いているが、半導体特性を向上させるために 300~350℃ 程度の成膜温度で水素 (H₂) を付加しながら成膜されている。このようにして形成される TFT 素子の耐熱温度は約 300℃ であり、TFT 素子をこれ以上の高温に曝すと a-Si 膜や p-Si 膜から水素が抜け出し半導体特性が劣化する。

【0017】

したがって、上述のアクティブマトリクス基板 50 上に MOCVD 法を用いて CdTe や CdZnTe を成膜することは、成膜温度の観点から事実上困難であった。

【0018】

本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、応答性が良く、さらに動画像にも対応できる二次元画像検出器およびその製造方法を提供することにある。

【0019】

【課題を解決するための手段】

請求項 1 の二次元画像検出器は、上記の課題を解決するために、格子状に配列された電極配線と、各格子点ごとに設けられた複数のスイッチング素子と、該スイッチング素子を介して該電極配線に接続される画素電極とからなる画素配列層を含むアクティブマトリクス基板と、該画素配列層のほぼ全面に対向して形成さ

れる電極部と、該画素配列層および該電極部の間に形成される光導電性を有する半導体層とを含む対向基板とを備えており、これら両基板が、該アクティブマトリクス基板の画素配列層と、該対向基板の半導体層とが対向するように配置されるとともに、該画素電極に対応してパターン形成された導電性および接着性を有する導電接続材によって接続されており、さらに、これら両基板の間隙に、両基板の間隔を保持する間隔保持材がパターン形成されていることを特徴としている。

【0020】

上記の構成により、画素配列層を含むアクティブマトリクス基板と電極部および半導体層を含む対向基板とを、画素電極に対応してパターンニングされた導電性および接着性を有する導電接続材によって接続することで、上記アクティブマトリクス基板と対向基板とを別々に作成することが可能となる。

【0021】

よって、従来では、既に画素配列層が形成されている基板上に、半導体層を形成していたため、半導体層の形成時に、該画素配列層のスイッチング素子に対して悪影響を与えるような熱処理を必要とする半導体材料を使用することはできなかったが、上記構成によってアクティブマトリクス基板と対向基板とを別々に作成することが可能となり、従来では使用できなかった材料を上記半導体層に使用することができる。

【0022】

そして、上記構成により使用可能となる半導体材料としては、例えばCdTeもしくはCdZnTe化合物半導体があるが、これらの半導体材料は、従来用いられていたa-Seに比べX線等の放射線に対する感度(S/N比)が高いため、上記半導体層にCdTeもしくはCdZnTe化合物半導体を用いることによって、二次元画像検出器の応答性が改善される。

【0023】

また、この場合、電極部に印加される電圧を従来よりも低く設定することができるので、従来では半導体層と電極部との間において高電圧保護のために設けられていた誘電体層を省略することができる。ゆえに、上記従来構成、すなわち

、半導体層と電極部との間に誘電体層を設ける構成においては、該誘電体層に残留する電荷を1フレームごとに除去する工程（シーケンス）が必要となるため、従来の二次元画像検出器では、静止画像の検出しか行えなかったが、上記誘電体層を省略することで、動画像の検出も可能となる。

【0024】

さらに、上記アクティブマトリクス基板および対向基板の両基板は、画素電極に対応してパターニングされた導電接続材で接続されるので、アクティブマトリクス基板の画素ごとに電氣的絶縁性が確保され、隣り合う画素同士のクロストークを発生させることなく、アクティブマトリクス基板上の画素電極と、対向基板の半導体層とを電氣的および物理的に接続することが可能となる。

【0025】

加えて、間隔保持材を配設することにより、両基板の接続不良が発生しない程度に強くプレスして貼り合わせ接続を行ったとしても、上記間隔保持材が両基板の間隔（ギャップ）を一定以上に保持することができる。したがって、両基板の間隔が所定の値より狭くなることがなく、隣接して設けられている導電接続材同士が接触する（リーク不良）ことを防ぐことが可能となる。

【0026】

また、上記間隔保持材をパターン形成することにより、導電接続材が存在しない部分にのみ間隔保持材を配置することができる。よって、誘導接続材に要求される導電性や接着剤に悪影響を与えることなく、上記の効果を得ることが可能となる。

【0027】

請求項2の二次元画像検出器は、上記の課題を解決するために、請求項1の構成に加えて、上記間隔保持材は、上記導電接続材を囲むように格子状に形成されていることを特徴としている。

【0028】

上記の構成により、請求項1の構成による作用に加えて、導電接続材や間隔保持材のパターン精度が悪い場合、あるいは導電接続材が押しつぶされて形状が変化した場合に、たとえ両者が接触する状態になったとしても、隣接して設けられ

ている導電接続材同士は間隔保持材によって隔てられているため、導電接続材同士が接触する（リーク不良）ことを防ぐことが可能となる。

【0029】

請求項3の二次元画像検出器は、上記の課題を解決するために、請求項1または2の構成に加えて、上記間隔保持材は、電気絶縁性を有する材料によって形成されていることを特徴としている。

【0030】

上記の構成により、請求項1または2の構成による作用に加えて、導電接続材や間隔保持材のパターン精度が悪い場合、あるいは導電接続材が多少押しつぶされて形状が変化した場合に、たとえ両者が接触する状態になったとしても、隣接して設けられている導電接続材同士の間には絶縁性の間隔保持材が配設されているため、電氣的にリークすることをより確実に防ぐことができる。

【0031】

請求項4の二次元画像検出器は、上記の課題を解決するために、請求項1から3の何れかの構成に加えて、上記間隔保持材は、上記導電接続材の接続工程の熱圧着環境下において、該導電接続材より高い硬度を有するように設定されていることを特徴としている。

【0032】

上記の構成により、請求項1から3の何れかの構成による作用に加えて、熱圧着によりアクティブマトリクス基板と対向基板の貼り合わせ接続を行う場合、導電接続材がわずかに軟化する温度環境下であっても、間隔保持材は十分な間隔保持力を発揮することが可能となる。

【0033】

請求項5の二次元画像検出器は、上記の課題を解決するために、請求項1から4の何れかの構成に加えて、上記間隔保持材は、ポリイミド高分子材料よりなっていることを特徴としている。

【0034】

上記の構成により、請求項1から4の何れかの構成による作用に加えて、電気絶縁性に優れており、軟化点も300℃以上であり、さらに放射線に対しても安

定であるという優れた特性を有する間隔保持材を実現することができる。

【0035】

請求項6の二次元画像検出器は、上記の課題を解決するために、請求項1から5の何れかの構成に加えて、上記間隔保持材は、電気絶縁性を有する液状の樹脂材料中に、上記導電接続材の接続工程の熱圧着環境下での変形量が小さく、電気絶縁性を有する補助材が混入されたものであることを特徴としている。

【0036】

上記の構成により、請求項1から5の何れかの構成による作用に加えて、間隔保持材の樹脂材料が軟質である場合でも、その中に電気絶縁性を有する補助材を分散させておくことで、十分な間隔保持力を発揮することが可能となる。

【0037】

請求項7の二次元画像検出器の製造方法は、上記の課題を解決するために、格子状に配列された電極配線と、各格子点ごとに設けられた複数のスイッチング素子と、該スイッチング素子を介して該電極配線に接続される画素電極とからなる画素配列層を含むアクティブマトリクス基板、および、該画素配列層のほぼ全面に対向して形成される電極部と、該画素配列層および該電極部の間に形成される光導電性を有する半導体層とを含む対向基板のうち、どちらか一方の基板上に、該画素電極に対応して導電性および接着性を有する導電接続材をパターン形成する第一の工程と、他方の基板上に、電気絶縁性を有し、両基板の間隔を保持する間隔保持材を該導電接続材を囲むように格子状にパターン形成する第二の工程と、両基板を、該アクティブマトリクス基板の画素配列層と、該対向基板の半導体層とが対向するように配置する第三の工程と、両基板を、該導電接続材を介して接続して貼り合わせる第四の工程とを含んでいることを特徴としている。

【0038】

上記の構成によれば、従来のように、既に画素配列層が形成されている基板上に新たに半導体層を形成する必要がない。このため、従来では半導体層の形成時に該画素配列層のスイッチング素子に対して悪影響を与える熱処理を必要とするような半導体材料を使用することはできなかったが、アクティブマトリクス基板と対向基板とを別々に作成することで、従来では使用できなかった材料、例えば

CdTeもしくはCdZnTe化合物半導体を上記半導体層に使用することが可能となる。

【0039】

これらの半導体材料は、従来用いられていたa-Seに比べX線等の放射線に対する感度（S/N比）が高いため、上記半導体層にCdTeもしくはCdZnTe化合物半導体を用いることにより、二次元画像検出器の応答性が良くなり、動画像の検出も可能となる。

【0040】

さらに、上記アクティブマトリクス基板および対向基板の両基板は、画素電極に対応してパターンニングされた接続材で接続されるので、アクティブマトリクス基板の画素ごとに電氣的絶縁性が確保され、隣り合う画素同士のクロストークを発生させることなく、アクティブマトリクス基板上の画素電極と、対向基板の半導体層とを電氣的及び物理的に接続することが可能となる。

【0041】

加えて、間隔保持材を配設することにより、両基板の接続不良が発生しない程度に強くプレスして貼り合わせ接続を行ったとしても、上記間隔保持材が両基板の間隔（ギャップ）を一定以上に保持することができる。したがって、両基板の間隔が所定の値より狭くなることなく、隣接して設けられている導電接続材同士が接触する（リーク不良）ことを防ぐことが可能となる。

【0042】

また、上記間隔保持材をパターン形成することにより、導電接続材が存在しない部分にのみ間隔保持材を配置することができる。よって、誘導接続材に要求される導電性や接着剤に悪影響を与えることなく、上記の効果を得ることが可能となる。

【0043】

さらに、個々の材料のパターン形成を容易に行うことができる。なお、一方の基板上に導電接続材および間隔保持材をパターン形成することも可能ではあるが、先に形成したパターンが、後のパターン形成の障害となるので、極めて困難である。

【0044】

請求項8の二次元画像検出器の製造方法は、上記の課題を解決するために、請求項7の構成に加えて、上記の第一および第二の工程では、上記の導電接続材および間隔保持材を、上記のアクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせ前における高さが該間隔保持材よりも該導電接続材の方が大きくなるようにパターン形成することを特徴としている。

【0045】

上記の構成により、請求項7の構成による作用に加えて、アクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせにおいて、両基板の間隔が間隔保持材の高さに達するまでプレスを行うことができる。よって、導電接続材が間隔保持材との高さの差だけ押しつぶされて、導電接続材を両基板に完全に密着させることができる。したがって、確実な導電接続を得ることが可能となる。

【0046】

【発明の実施の形態】

まず、本発明の一実施の形態の前提となる技術について、図8および図9を参照しながら説明する。

【0047】

前述した従来の放射線二次元画像検出器が有する問題点を解決する方法として、CdTeやCdZnTeなどの光導電膜を、一旦別の支持基板上に300℃以上の高温で成膜し、その後、支持基板とアクティブマトリクス基板とを300℃以下の低温で貼り合わせ接続する方法がある。

【0048】

図8および図9は、XYマトリクス電極、TFT、画素電極、電荷蓄積容量などを備えているアクティブマトリクス基板と、支持基板上に上部電極、半導体層（光導電膜）、接続電極（電荷収集電極）などが具備されている対向基板とが、画素ごとに設けられた導電接続材で互いに接続された構造の二次元画像検出器の断面構成図であり、図8が全体断面図、図9が1画素当たりの詳細断面図（図8の領域B）である。

【0049】

上記の構造を採用することにより、二次元画像検出器に、CdTeやCdZnTeなどの光導電膜を使用することが可能となり、その結果、リアルタイムでの動画撮影が可能となる。

【0050】

しかしながら、上記二次元画像検出器は、以下のような構造上の問題を有している。

【0051】

図8および図9に示した二次元画像検出器では、上記アクティブマトリクス基板と対向基板とを対向させた状態で貼り合わせる工程が必要になる。このとき、二次元画像検出器自身が大面積の形態を有する場合、両基板を全面にわたって均一な間隙（ギャップ）で貼り合わせる事が困難となる。

【0052】

このため、例えば、面積が400mm×500mm程度の基板同士を貼り合わせると、部分的に基板間隙の広い場所が発生し、導電接続材の接続不良が発生することがあった。また、それを防ぐために、強いプレス力で両基板を貼り合わせようとする、部分的に基板間隙の狭い場所が発生して、その場所の導電接続材が押しつぶされてしまい、隣接する導電接続材同士の接触（リーク不良）が発生することがあった。

【0053】

以下、本発明の一実施の形態について、図1から図7を参照しながら説明する。なお、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、前述した従来の放射線二次元画像検出器が有する問題点を解決するとともに、大面積を有するアクティブマトリクス基板と対向基板とを貼り合わせて接続する際にも、両基板間の間隙（ギャップ）を面内で均一にするとともに、両基板間の接続不良やリーク不良の発生を抑制することができるものである。

【0054】

まず、図1および図2を用いて、本実施の形態に係る二次元画像検出器の基本構成を説明する。図1は上記二次元画像検出器の全体断面図であり、図2は図1

の領域 A の詳細断面図である。

【0055】

図 1 に示すように、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、画素電極 14 が形成されたアクティブマトリクス基板 1 と、電荷収集電極 6 が形成された対向基板 2 とが、画素電極 14 と電荷収集電極 6 とが対向して接続されるように、各画素ごとに独立して設けられた導電接続材 3 および間隔保持材 45 を介して貼り合わされた構造である。

【0056】

図 2 に示すように、上記アクティブマトリクス基板 1 は、ガラス基板 7 上に X Y マトリクス状の電極配線（ゲート電極 8 およびソース電極 9）、TFT（薄膜トランジスタ）（スイッチング素子）5、電荷蓄積容量 4、蓄積容量（Cs）電極 10 などからなる画素配列層 40 が形成されている。上記アクティブマトリクス基板 1 は、液晶表示装置を製造する過程で形成されるアクティブマトリクス基板と同じプロセスによって形成することができる。図 2 を参照しながら、具体的に説明する。

【0057】

上記ガラス基板 7 は、無アルカリガラス基板である。ガラス基板 7 としては、例えば、コーニング社製 #7059 や #1737 を使用することができる。

【0058】

上記ゲート電極 8 および Cs 電極 10 は、ガラス基板 7 の上に Ta, Al などの金属膜をスパッタ蒸着により約 3000 Å 成膜後、所望の形状にパターニングして形成される。

【0059】

上記のゲート電極 8 および Cs 電極 10 の上に、絶縁膜 11 が SiNx や SiOx により CVD 法で約 3500 Å 成膜して形成される。絶縁膜 11 は、ゲート絶縁膜あるいは蓄積容量（Cs）として作用する。なお、絶縁膜 11 としては、SiNx や SiOx だけでなく、ゲート電極 8 および Cs 電極 10 を陽極酸化した陽極酸化膜を併用することもできる。

【0060】

上記TFT5のチャネル部となるi型のa-Si膜12と、ソース電極9およびドレイン電極とのコンタクトを図る n^+ 型のa-Si膜13とが、CVD法でそれぞれ約1000Å、約400Å成膜後、所望の形状にパターニングして形成される。

【0061】

上記のソース電極9および画素電極14は、TaやAlなどの金属膜であり、スパッタ蒸着で約3000Å成膜後、所望の形状にパターニングして形成される。なお、本実施の形態では、画素電極14とドレイン電極とを兼用しているが、画素電極14とドレイン電極を別々に形成してもよく、また、画素電極14にITO (indium tin oxide) などの透明電極を使用することも可能である。

【0062】

その後、画素電極14の開口部以外の領域を絶縁保護するために、絶縁保護膜15が、SiN_xやSiO_xの絶縁膜をCVD法で約6000Å成膜後、所望の形状にパターニングして形成される。なお、絶縁保護膜15には、無機の絶縁膜の他に、アクリルやポリイミド等の有機膜を使用することも可能である。

【0063】

以上の工程により、アクティブマトリクス基板1を形成することができる。なお、ここでは、TFT素子として、a-Siを用いた逆スタガ構造のTFT5を用いたが、これに限定されるものではなく、p-Siを用いてもよいし、スタガ構造にしてもよい。

【0064】

また、上記対向基板2は、以下のプロセスにより形成することができる。

【0065】

ガラス基板31は、対向基板2の支持基板であり、X線や可視光に対して透過性を有する。ガラス基板31としては、厚さ約0.7mm~1.1mmのガラス基板（例えば、コーニング社製#7059や#1737）を用いることができる。

【0066】

上部電極（電極部）17は、Ta、Auなどの導電膜であり、ガラス基板31の片面のほぼ全面に形成される。なお、上部電極17として可視光に対して透明なITO電極を用いることにより、二次元画像検出器を可視光に対応させることが可能である。

【0067】

半導体層32は、CdTeやCdZnTeの多結晶膜であり、上部電極17上にMOCVD法を用いて約0.5mmの厚みで形成される。なお、MOCVD法は大面積基板への成膜に適しており、原料である有機カドミウム（ジメチルカドミウム[DMCd]）、有機テルル（ジエチルテルル[DETe]やジイソプロピルテルル[DiPTe]）、有機亜鉛（ジエチル亜鉛[DEZn]やジイソプロピル亜鉛[DiPZn]やジメチル亜鉛[DMZn]）を用いて400～500℃の成膜温度で成膜が可能である。さらに、CdTeやCdZnTeの成膜方法としては、上記MOCVD法の他にスクリーン印刷・焼成法、スプレー法、電析法、近接昇華法等を用いることも可能である。

【0068】

キャリア阻止層18は、AlO_xの薄い絶縁層であり、半導体層32のほぼ全面に形成される。なお、キャリア阻止層18の構造としては、上記MIS（metal-insulator-semiconductor）接合構造の他に、PIN（positive-intrinsic-negative diode）接合構造、ショットキー接合構造を用いることも、もちろん可能である。また、キャリア阻止層18は必要に応じて画素ごとにパターニングすることもできる。

【0069】

上記電荷収集電極（接続電極）6は、Au、ITOなどの導電膜であり、キャリア阻止層18の上に約2000Å成膜後、所望の形状にパターニングして形成される。電荷収集電極6は、アクティブマトリクス基板1に形成された画素電極14と対向する位置に形成することができる。

【0070】

そして、図1に示すように、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、以上の

プロセスにより形成されたアクティブマトリクス基板 1 と対向基板 2 とが、画素電極 14 と電荷収集電極 6 とが対向して接続するように、各画素ごとに独立して設けられた導電接続材 3 により貼り合わせて形成されている。このとき、アクティブマトリクス基板 1 と対向基板 2 との間には、導電接続材 3 が存在しない場所に、間隔保持材 45 が設けられている。

【0071】

つづいて、図 3 から図 6 を参照しながら、上記の導電接続材 3 および間隔保持材 45 の具体的な形成方法について説明する。

【0072】

まず、図 3 (a), (b) に示すように、アクティブマトリクス基板 1 および対向基板 2 のそれぞれの貼り合わせ面に、導電接続材 3 および間隔保持材 45 をそれぞれパターン形成する。なお、このとき導電接続材 3 および間隔保持材 45 の両者をどちらか一方の基板に形成することも可能である。しかし、導電接続材 3 および間隔保持材 45 をそれぞれ別個の基板上に形成すると、パターンニング処理を独立して行なえる点でより望ましい。そこで、本実施の形態では、アクティブマトリクス基板 1 上に導電接続材 3 を (図 3 (a) : 第一の工程)、対向基板 2 上に間隔保持材 45 を (図 3 (b) : 第二の工程) それぞれパターン形成する。

【0073】

アクティブマトリクス基板 1 上に導電接続材 3 をパターン形成する方法としては、以下の方法が可能である。

(A1) アクティブマトリクス基板 1 の貼り合わせ面のほぼ全面に導電性を有する感光性樹脂層を形成した後、フォトリソグラフィ技術により導電接続材 3 をパターン形成する。

(A2) アクティブマトリクス基板 1 の貼り合わせ面に、スクリーン印刷やインクジェット法などの印刷手段により、導電接着剤を印刷することによって導電接続材 3 をパターン形成する。

(A3) アクティブマトリクス基板 1 の貼り合わせ面に導電性樹脂を電着させることにより導電接続材 3 をパターン形成する。

【0074】

特に、(A1)の方法は、導電接続材3を精度良くパターン形成できるとともに、画素電極14に対して任意の形状に設計できる点で優れている。したがって、本実施の形態では、ドライフィルム状の導電性を有する感光性樹脂をアクティブマトリクス基板1上のほぼ全面に転写した後、該感光性樹脂に露光・現像処理を施すことにより、導電接続材3を画素電極14上にパターン形成する。なお、この時の感光性樹脂、すなわち導電接続材3の高さH2は、約 $10\mu\text{m}$ となるよう設計した。

【0075】

一方、対向基板2上に間隔保持材45をパターン形成する方法としては、以下の方法が可能である。

(B1) 対向基板2の貼り合わせ面のほぼ全面に絶縁性の感光性樹脂層を形成した後、フォトリソグラフィ技術により間隔保持材45をパターン形成する。

(B2) 対向基板2上の貼り合わせ面のほぼ全面に有機または無機の絶縁性材料からなる層を形成した後、その上に感光性フォトレジスト層を形成し、フォトリソグラフィ技術とエッチング技術とを用いて間隔保持材45を該絶縁材料によってパターン形成する。

(B3) 対向基板2上の貼り合わせ面に、スクリーン印刷やインクジェット法などの印刷手段により、絶縁性ペーストを印刷することによって間隔保持材45をパターン形成する。

特に、(B1)の方法は、間隔保持材45を精度良くパターン形成できるとともに、画素電極14に対して任意の形状に設計できる点で優れている。したがって、本実施の形態では、絶縁性の感光性樹脂を対向基板2の貼り合わせ面のほぼ全面に塗布し、プレ焼成を施した後、該感光性樹脂の露光・現像、およびポスト焼成処理を施すことにより、対向基板2上に電荷収集電極6を囲む形状にパターン形成する。なお、この時の感光性樹脂、すなわち間隔保持材45の高さH1は、約 $8\mu\text{m}$ となるよう設計した。

【0076】

ここで、上記の導電接続材 3 の高さ H_2 および間隔保持材 4 5 の高さ H_1 は、 $5\mu\text{m}$ 以上かつ $30\mu\text{m}$ 以下の範囲内であることが望ましい。その理由は、高さ H_1 および高さ H_2 が $5\mu\text{m}$ より低いと、後述するアクティブマトリクス基板 1 と対向基板 2 とを接続する工程において、両基板の間隙が小さくなり過ぎ、ゴミや埃による接続不良が生じやすくなり、反対に高さ H_1 および高さ H_2 が $30\mu\text{m}$ より高いと、導電接続材 3 および間隔保持材 4 5 のパターニングが困難になるという問題が生じるためである。なお、導電接続材 3 の高さ H_2 および間隔保持材 4 5 の高さ H_1 の望ましい相対関係については、後で詳細に説明する。

【0077】

つぎに、図 3 (c) に示すように、導電接続材 3 がパターン形成されたアクティブマトリクス基板 1 と、間隔保持材 4 5 がパターン形成された対向基板 2 とを、互いの画素が一致するように両基板の貼り合わせ面を対向配置して位置合わせを行う（第三の工程）。このとき、導電接続材 3 と間隔保持材 4 5 とが重ならないように、両基板の位置ずれを解消する。

【0078】

つづいて、図 3 (d) に示すように、位置合わせされたアクティブマトリクス基板 1 および対向基板 2 に加熱圧着処理を施して、両基板を接続する（第四の工程）。

【0079】

ここで、加熱圧着処理の際（図 3 (d)）、間隔保持材 4 5 は導電接続材 3 よりも変形しにくいことが望ましい。なぜならば、導電接続材 3 は、ある程度軟化した方が両基板との接着性が向上するのに対して、間隔保持材 4 5 は、形状が変化し難いことで間隔保持力が向上するためである。

【0080】

例えば、導電接続材 3 に 130°C 前後で軟化して接着性（粘着性）が発現する材料を、間隔保持材 4 5 に 150°C 以上で軟化する材料をそれぞれ用いる場合を考える。このとき、加熱圧着処理を $130\sim 150^\circ\text{C}$ の温度で行うと、導電接続材 3 は軟化して両基板に接着し易くなる。これに対して、間隔保持材 4 5 は、1

30～150℃では軟化しないため、間隔保持力を保ったまま貼り合わせることができる。

【0081】

すなわち、導電接続材3が軟化することで接着性を生じる材料の場合には、その軟化温度が間隔保持材45の軟化温度より低いことが望ましい。なお、導電接続材3として熱硬化性あるいは光硬化性の接着剤を用いることもできるが、この場合は接着剤が最初から粘性を有しており十分に變形し易いものが多い。よって、そのような接着剤を導電接続材3に用いる場合には、間隔保持材45が變形し難ければよい。

【0082】

具体的には、間隔保持材45には、軟化温度が比較的高い材料である、感光性のポリイミド高分子材料を採用することができる。すなわち、ポリイミド高分子材料は電気絶縁性に優れており、軟化点も300℃以上であり、さらに放射線に対しても安定な材料であるため、本実施の形態の間隔保持材45の材料として最適である。

【0083】

また、上記間隔保持材45は、ポリイミド高分子材料の他に、エポキシ系、アクリル系、ウレタン系等の高分子材料、あるいはゾルゲル成膜法や塗布法、ペースト印刷法等によって得られる SiO_2 等の無機系絶縁膜などを、上記の(B1)～(B3)の方法を用いて形成することも可能である。

【0084】

図4(a)，(b)は、それぞれアクティブマトリクス基板1と対向基板2との貼り合わせの前後における、導電接続材3および間隔保持材45の断面図である。

【0085】

上述のように、本実施の形態では、貼り合わせ前の間隔保持材45の高さH1を8μm、導電接続材3の高さH2を10μmとなるように設定している(図4(a))。このため、アクティブマトリクス基板1と対向基板2とを貼り合わせると、両基板の基板間隙は、間隔保持材45の高さH1で決定されるため、加熱

により軟化した導電接続材 3 がわずかに押しつぶされることになる（図 4（b））。これにより、導電接続材 3 を確実に両基板に接触させることができる。ゆえに、間隔保持材 4 5 の高さ H_1 、および導電接続材 3 の高さ H_2 を、 $H_2 \geq H_1$ となるように設計するとよい。

【0086】

そして、図 4（b）に示すように、アクティブマトリクス基板 1 と対向基板 2 との貼り合わせによって、両基板の基板間隙が導電接続材 3 の高さ H_2 よりも小さくなるため、導電接続材 3 のパターン面積が貼り合わせ前後で W_1 から W_2 へ、 $W_2 - W_1$ だけ広がることになる。よって、導電接続材 3 の貼り合わせ前のパターン面積 W_1 を、貼り合わせ後のパターン面積 W_2 が画素電極 1 4 の面内に収まるように設計するとよい。現実的には、貼り合わせ前後での導電接続材 3 のパターン面積の変化を 2 倍以内に抑えておくことが、隣接画素へのリークを防ぐ点で有効である。ゆえに、間隔保持材 4 5 の高さ H_1 、および導電接続材 3 の高さ H_2 を、 $2 \times H_1 \geq H_2$ となるように設計するとよい。

【0087】

以上より、導電接続材 3 の高さ H_2 の最適設計条件は、間隔保持材 4 5 の高さ H_1 に対して、 $2 \times H_1 \geq H_2 \geq H_1$ となる。なお、この条件によって設計しておくことで、基板が大面積化した場合でも、導電接続材 3 および間隔保持材 4 5 の厚みのバラツキをある程度吸収することができるため、電荷収集電極 6 と画素電極 1 4 との確実な接続を得ることができる。

【0088】

つぎに、典型的なパターン形状を、図 5 および図 6 を参照して説明する。図 5 は、アクティブマトリクス基板 1 上の各部材の配置を示す平面図である。図 6 は、アクティブマトリクス基板 1 に対する導電接続材 3 および間隔保持材 4 5 の配置関係を示す平面図である。

【0089】

図 5 および図 6 に示すように、導電接続材 3 は画素電極 1 4 上に独立した島状に設けられ、間隔保持材 4 5 は画素電極 1 4 を囲むようにマトリクス状に設けられている。よって、隣接する導電接続材 3 同士の間には必ず間隔保持材 4 5 が配

設されているため、導電接続材 3 や間隔保持材 4 5 のパターン精度が悪い場合、あるいは導電接続材 3 が押しつぶされて形状が変化した場合に、導電接続材 3 と間隔保持材 4 5 とが接触することはあっても、隣接する導電接続材 3 間に電氣的にリークが生じることは確実に防ぐことができる。

【0090】

ここで、上記のように、間隔保持材 4 5 のパターンが画素を囲む格子状の場合、両基板の貼り合わせ時に、格子に囲まれた空間に空気が閉じ込められやすく、導電接続材 3 の接着面に気泡を巻き込む等のプレス不良が発生する可能性がある。このような場合は、減圧環境下でプレス貼り合わせを行なうとよい。

【0091】

なお、間隔保持材 4 5 のパターンは、図 5 および図 6 に示すパターンに限定されるものではなく、ストライプ形状やドット形状など必要に応じてパターン形成することができる。

【0092】

また、間隔保持材 4 5 のパターンは、マトリクス状の画素が存在する撮像有効領域のみならず、撮像有効領域の周辺部にも余分にダミーパターンとして設けることが望ましい。これより、両基板を貼り合わせる際、基板周辺部においても基板の間隔（ギャップ）を均一に保持することが可能となる。

【0093】

以上のように製造された本実施の形態に係る二次元画像検出器は、両基板の貼り合わせ時に、強くプレスして貼り合わせ接続を行っても、間隔保持材 4 5 が両基板の間隔を一定に保持するため、両基板の間隙（ギャップ）が所定の値より狭くなることはない。

【0094】

よって、上記二次元画像検出器は、大面積の基板（例えば、基板サイズが 400mm×500mm 程度以上）を有するものであっても、基板間隙を均一に保った状態で貼り合わせることができる。その結果、歩留まり良く、確実な接続を得ることが可能となる。また、間隔保持材 4 5 を設けることにより、導電接続材 3 が押しつぶされすぎることがなく、隣接する導電接続材 3 同士の接触（リーク不

良)の発生を防ぐことが可能となる。

【0095】

つづいて、図7を用いて、間隔保持材45の硬さが充分でなく、間隔保持力が充分に発揮できない場合について説明する。

【0096】

図7に示すように、間隔保持材45として、樹脂材料45aの中に電気絶縁性を有する球状の補助材45bを混入させたものを使用することができる。このように、樹脂材料45a中に補助材45bが混入された間隔保持材45を使用することにより、間隔保持材45の樹脂材料45aの硬さが導電接続材3より弱い場合でも、樹脂材料45aに混入された球状の補助材45bで両基板の間隔を保持することが可能となる。

【0097】

上記補助材45bとしては、ガラス、セラミック、プラスチック製のものを利用することができる。特に、ガラスやセラミック製の補助材45bは、電気絶縁性を有するとともに、加熱および加圧に対する変形量が小さく、間隔保持材45の樹脂材料45aに混入する強度補助材料として最適である。

【0098】

そして、上記補助材45bを樹脂材料45aに混入してパターニングすることにより、補助材45bがパターニングされた樹脂材料45a中にのみ存在するので、補助材45bが導電接続材3の接着面に介在して導電接続材3の接着を妨げることはない。

【0099】

なお、上記補助材45bは、樹脂材料45aに混入されて両基板間の間隔を保持できるものであればよく、その形状は球状に限定されず、粒状や繊維(ファイバ状)などであってもよい。ただ、球状の補助材45bを用いると、樹脂材料45aを均一に塗布でき、パターン形成がし易いという利点がある。なお、補助材45bの対向基板2の基板面からの高さは、上述した間隔保持材45の高さH1とほぼ等しいことが望ましい。

【0100】

つづいて、導電接続材 3 および間隔保持材 4 5 のパターン形成をスクリーン印刷を用いて行う場合について説明する。

【0101】

上述したように、導電接続材 3 および間隔保持材 4 5 は、それ自身が感光性を有する材料を用いて、フォトリソグラフィ技術によりパターン形成を行うことができる。

【0102】

しかし、導電接続材 3 および間隔保持材 4 5 は、スクリーン印刷を用いてパターン形成することも可能である。この場合、導電接続材 3 のスクリーン印刷には Ni 系のメタルマスクを、間隔保持材 4 5 のスクリーン印刷には通常のメッシュスクリーン版を用いることができる。

【0103】

導電接続材 3 のパターンは直径が $\Phi 50 \mu\text{m}$ 程度と細かいため、通常のメッシュスクリーン版ではきれいな印刷穴が形成できない。そこで、導電接続材 3 のスクリーン印刷には Ni 系のメタルマスクが適している。なお、導電接続材 3 には、Ag 系の導電粒子が含まれるエポキシ系接着ペーストを用いるとよい。

【0104】

これに対して、間隔保持材 4 5 のスクリーン印刷には、通常のメッシュスクリーン版を用いることができる。なお、間隔保持材 4 5 には、ポリイミド高分子材料等からなる各種絶縁性印刷材料を使用することが可能である。

【0105】

このように、導電接続材 3 および間隔保持材 4 5 のパターン形成にスクリーン印刷を用いると、フォトリソグラフィに比べてパターン精度が劣るものの、製造装置が安価となる。よって、画素ピッチが荒い二次元画像検出器に対しては非常に有効である。

【0106】

なお、本実施の形態は本発明の範囲を限定するものではなく、本発明の範囲内で種々の変更が可能である。例えば、以下のように構成することもできる。

【0107】

上記二次元画像検出器は、X線等の放射線に対する光導電性だけでなく、可視光や赤外光に対しても光導電性を示す半導体（光導電体）を使用することにより、X線（放射線）に加えて可視光や赤外光にも対応した二次元画像検出器としても使用することができる。

【0108】

ただし、この場合には、半導体（光導電体）の入射側に配設される上部電極 17（図 2）に、ITO、 SnO_2 等からなる可視光や赤外光を透過する透明電極を用いる必要がある。また、半導体（光導電体）の厚みも、可視光、赤外光の吸収効率に応じて最適化する必要がある。

【0109】

さらに、導電接続材 3 および間隔保持材 4 5 のパターン形成については、上述してきた光導電膜（半導体層）やセンサ構造によって限定されるものではなく、他の光導電材料やセンサ構造を用いた二次元画像検出器にも適用することができる。例えば、 $\alpha\text{-Se}$ や $\alpha\text{-Si}$ 等の半導体材料を光導電膜として使用することも可能である。

【0110】

また、対向基板（センサ基板）側の構造は、ガラス基板等の支持基板を持たずに半導体基板自身が支持基板の役割を果たす構造でもよいし、X線を可視光に変換する変換層（例えば CsI）と可視光センサを組み合わせた構造であってもよい。

【0111】

さらに、間隔保持材 4 5 は、アクティブマトリクス基板 1 および対向基板 2 の両者に対して接着性あるいは粘着性を有する材料であってもよく、この場合、両基板の接続強度が向上する。

【0112】

以上のように、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、格子状に配列された電極配線と、各格子点ごとに設けられた複数のスイッチング素子と、該スイッチング素子を介して該電極配線に接続される画素電極とからなる画素配列層と、該

画素配列層のほぼ全面に対向して形成される電極部と、該画素配列層および該電極部の間に形成される光導電性を有する半導体層とを備えているのに加えて、上記画素配列層を含むアクティブマトリクス基板と、上記の電極部および半導体層を含む対向基板とを備えており、該アクティブマトリクス基板の画素配列層と、該対向基板の半導体層とが対向するように両基板が配置されており、これら両基板が上記画素電極に対応してパターンニングされた導電性および接着性を有する導電接続材によって接続されているものであって、さらに、上記アクティブマトリクス基板と対向基板との間隙に、パターン形成された間隔保持材が配設されている。

【0113】

このように、間隔保持材を配設することにより、両基板の接続不良が発生しない程度に強くプレスして貼り合わせ接続を行ったとしても、上記間隔保持材が両基板の間隔（ギャップ）を一定以上に保持することができる。よって、両基板の間隔が所定の値より狭くなることがなく、隣接して設けられている導電接続材同士が接触する（リーク不良）ことを防ぐことが可能となる。

【0114】

なお、上記間隔保持材をパターン形成することにより、導電接続材が存在しない部分にのみ間隔保持材を配置することができる。よって、誘導接続材に要求される導電性や接着剤に悪影響を与えることなく、上記の効果を得ることが可能となる。

【0115】

また、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、上記間隔保持材が、絶縁性材料によって形成されている。

【0116】

このように、絶縁性材料からなる間隔保持材を使用することにより、導電接続材や間隔保持材のパターン精度が悪い場合、あるいは導電接続材が多少押しつぶされて形状が変化した場合に、たとえ両者が接触する状態になったとしても、隣接して設けられている導電接続材同士の間には絶縁性の間隔保持材が配設されているため、電氣的にリークすることを防ぐことができる。

【0117】

また、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、上記のアクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせ前における上記間隔保持材の高さ H_1 と上記導電接続材の高さ H_2 との関係が、 $2 \times H_1 \geq H_2 \geq H_1$ の条件を満たすように設定されている。

【0118】

このように、導電接続材および間隔保持材の高さを $H_2 \geq H_1$ の条件を満たすように設定することにより、アクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせにおいて、両基板の間隔が間隔保持材の高さに達するまでプレスを行うことができる。よって、導電接続材が間隔保持材との高さの差 $\Delta H (= H_2 - H_1)$ だけ押しつぶされて、導電接続材を両基板に完全に密着させることができる。したがって、確実な導電接続を得ることが可能となる。

【0119】

また、導電接続材および間隔保持材の高さを $2 \times H_1 \geq H_2$ の条件を満たすように設定することにより、アクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせ前後での導電接続材の面積変化を2倍以内に抑えることができる。よって、隣接して設けられている導電接続材同士の接触による隣接画素へのリークをより確実に防止することができる。

【0120】

また、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、上記間隔保持材が、上記画素電極に対応してパターン形成された導電接続材を囲むように格子状に形成されている。

【0121】

このように、導電接続材を囲むように間隔保持材を配設することにより、導電接続材や間隔保持材のパターン精度が悪い場合、あるいは導電接続材が押しつぶされて形状が変化した場合に、たとえ両者が接触する状態になったとしても、隣接して設けられている導電接続材同士は間隔保持材によって隔てられているため、電氣的にリークすることは防ぐことができる。

【0122】

また、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、上記間隔保持材が、絶縁性の粒子状あるいはファイバ状（繊維状・繊維片）の補助材を液状の樹脂材料中に混入させたものである。

【0123】

このように、間隔保持材の樹脂中に補助材を混入させることにより、間隔保持材の樹脂が軟質な樹脂材料からなる場合でも、その中に絶縁性の粒子あるいはファイバ片を分散させておくことで、十分な間隔保持力を発揮することが可能となる。

【0124】

また、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、上記間隔保持材が、上記導電接続材の熱圧着による接続プロセス環境下において、上記導電接続材より高い硬度を有するように設定されている。

【0125】

このように、導電接続材の熱圧着状態における導電接続材および間隔保持材の硬度を設定することにより、熱圧着によりアクティブマトリクス基板と対向基板の貼り合わせ接続を行う場合、導電接続材がわずかに軟化する温度環境下であっても、間隔保持材は十分な間隔保持力を発揮することが可能となる。

【0126】

また、本実施の形態に係る二次元画像検出器は、上記間隔保持材がポリイミド高分子材料から形成されている。

【0127】

ポリイミド高分子材料は、電気絶縁性に優れており、軟化点も300℃以上であり、さらに放射線に対しても安定な材料である。よって、ポリイミド高分子材料を間隔保持材として好適に使用することができる。

【0128】

さらに、本実施の形態に係る二次元画像検出器の製造方法は、上記のアクティブマトリクス基板および対向基板のうち、どちらか一方の基板上に上記導電接続材をパターン形成するとともに、他方の基板上に上記間隔保持材をパターン配置

した後、両基板を貼り合わせて接続する。

【0129】

このように、導電接続材と間隔保持材とを別々の基板上に形成することにより、個々の材料のパターン形成を容易に行うことができる。なお、一方の基板上に導電接続材および間隔保持材をパターン形成することも可能ではあるが、先に形成したパターンが、後のパターン形成の障害となるので、極めて困難である。

【0130】

【発明の効果】

請求項1の発明の二次元画像検出器は、以上のように、格子状に配列された電極配線と、各格子点ごとに設けられた複数のスイッチング素子と、該スイッチング素子を介して該電極配線に接続される画素電極とからなる画素配列層を含むアクティブマトリクス基板と、該画素配列層のほぼ全面に対向して形成される電極部と、該画素配列層および該電極部の間に形成される光導電性を有する半導体層とを含む対向基板とを備えており、これら両基板が、該アクティブマトリクス基板の画素配列層と、該対向基板の半導体層とが対向するように配置されるとともに、該画素電極に対応してパターン形成された導電性および接着性を有する導電接続材によって接続されており、さらに、これら両基板の間隙に、両基板の間隔を保持する間隔保持材がパターン形成されている構成である。

【0131】

それゆえ、画素配列層を含むアクティブマトリクス基板と、電極部および半導体層を含む対向基板とを画素電極に対応してパターンニングされた導電接続材によって接続することで、上記アクティブマトリクス基板と対向基板とを別々に作成することが可能となる。

【0132】

よって、半導体層の成膜温度と、アクティブマトリクス基板上のスイッチング素子の耐熱性との関係により、従来では使用できなかった材料を上記半導体層に使用することができるという効果を奏する。特に、上記半導体層に、従来より感度（S/N比）が高い、例えばCdTeもしくはCdZnTe化合物半導体等を用いることで、従来よりも、二次元画像検出器の応答性を向上させることができ

ると共に、動画像の検出も可能となるという効果を奏する。

【0133】

加えて、間隔保持材を配設することにより、両基板の接続不良が発生しない程度に強くプレスして貼り合わせ接続を行ったとしても、間隔保持材が両基板の間隔（ギャップ）を一定以上に保持することができる。したがって、両基板の間隔が所定の値より狭くなることがなく、隣接して設けられている導電接続材同士が接触する（リーク不良）ことを防ぐことが可能となるという効果を奏する。

【0134】

また、上記間隔保持材をパターン形成することにより、導電接続材が存在しない部分にのみ間隔保持材を配置することができる。よって、誘導接続材に要求される導電性や接着剤に悪影響を与えることなく、上記の効果を得ることが可能となる。

【0135】

請求項2の発明の二次元画像検出器は、以上のように、請求項1の構成に加えて、上記間隔保持材は、上記導電接続材を囲むように格子状に形成されている構成である。

【0136】

それゆえ、請求項1の構成による効果に加えて、導電接続材や間隔保持材のパターン精度が悪い場合、あるいは導電接続材が押しつぶされて形状が変化した場合に、たとえ両者が接触する状態になったとしても、隣接して設けられている導電接続材同士は間隔保持材によって隔てられているため、導電接続材同士が接触する（リーク不良）ことを防ぐことができるという効果を奏する。

【0137】

請求項3の発明の二次元画像検出器は、以上のように、請求項1または2の構成に加えて、上記間隔保持材は、電気絶縁性を有する材料によって形成されている構成である。

【0138】

それゆえ、請求項1または2の構成による効果に加えて、導電接続材や間隔保持材のパターン精度が悪い場合、あるいは導電接続材が多少押しつぶされて形状

が変化した場合に、たとえ両者が接触する状態になったとしても、隣接して設けられている導電接続材同士の間には絶縁性の間隔保持材が配設されているため、電氣的にリークすることをより確実に防ぐことができるという効果を奏する。

【0139】

請求項4の発明の二次元画像検出器は、以上のように、請求項1から3の何れかの構成に加えて、上記間隔保持材は、上記導電接続材の接続工程の熱圧着環境下において、該導電接続材より高い硬度を有するように設定されている構成である。

【0140】

それゆえ、請求項1から3の何れかの構成による効果に加えて、熱圧着によりアクティブマトリクス基板と対向基板の貼り合わせ接続を行う場合、導電接続材がわずかに軟化する温度環境下であっても、間隔保持材は十分な間隔保持力を発揮することができるという効果を奏する。

【0141】

請求項5の発明の二次元画像検出器は、以上のように、請求項1から4の何れかの構成に加えて、上記間隔保持材は、ポリイミド高分子材料よりなっている構成である。

【0142】

それゆえ、請求項1から4の何れかの構成による効果に加えて、ポリイミド高分子材料によって間隔保持材を形成することにより、電気絶縁性に優れており、軟化点も300℃以上であり、さらに放射線に対しても安定であるという優れた特性を有する間隔保持材を実現することができるという効果を奏する。

【0143】

請求項6の発明の二次元画像検出器は、以上のように、請求項1から5の何れかの構成に加えて、上記間隔保持材は、電気絶縁性を有する液状の樹脂材料中に、上記導電接続材の接続工程の熱圧着環境下での変形量が小さく、電気絶縁性を有する補助材が混入されている構成である。

【0144】

それゆえ、請求項1から5の何れかの構成による効果に加えて、間隔保持材の

樹脂材料が軟質である場合でも、その中に電気絶縁性を有する補助材を分散させておくことで、十分な間隔保持力を発揮できるという効果を奏する。

【0145】

請求項7の発明の二次元画像検出器の製造方法は、以上のように、格子状に配列された電極配線と、各格子点ごとに設けられた複数のスイッチング素子と、該スイッチング素子を介して該電極配線に接続される画素電極とからなる画素配列層を含むアクティブマトリクス基板、および、該画素配列層のほぼ全面に対向して形成される電極部と、該画素配列層および該電極部の間に形成される光導電性を有する半導体層とを含む対向基板のうち、どちらか一方の基板上に、該画素電極に対応して導電性および接着性を有する導電接続材をパターン形成する第一の工程と、他方の基板上に、電気絶縁性を有し、両基板の間隔を保持する間隔保持材を該導電接続材を囲むように格子状にパターン形成する第二の工程と、両基板を、該アクティブマトリクス基板の画素配列層と、該対向基板の半導体層とが対向するように配置する第三の工程と、両基板を、該導電接続材を介して接続して貼り合わせる第四の工程とを含んでいる構成である。

【0146】

それゆえ、従来のように、既に画素配列層が形成されている基板上に新たに半導体層を形成する必要がない。よって、従来では使用できなかった材料、例えばCdTeもしくはCdZnTe化合物半導体を上記半導体層に使用することができるという効果を奏する。そして、これらの半導体材料を用いることにより、二次元画像検出器の応答性が改善され、動画像の検出も可能となるという効果を奏する。

【0147】

加えて、間隔保持材を配設することにより、両基板の接続不良が発生しない程度に強くプレスして貼り合わせ接続を行ったとしても、上記間隔保持材が両基板の間隔（ギャップ）を一定以上に保持することができる。したがって、両基板の間隔が所定の値より狭くなることがなく、隣接して設けられている導電接続材同士が接触する（リーク不良）ことを防ぐことができるという効果を奏する。

【0148】

また、上記間隔保持材をパターン形成することにより、導電接続材が存在しない部分にのみ間隔保持材を配置することができる。したがって、誘導接続材に要求される導電性や接着剤に悪影響を与えることなく、上記の効果を得ることが可能となる。

【0149】

さらに、個々の材料のパターン形成を容易に行うことができるという効果を奏する。なお、一方の基板上に導電接続材および間隔保持材をパターン形成することも可能ではあるが、先に形成したパターンが、後のパターン形成の障害となるので、極めて困難である。

【0150】

請求項8の発明の二次元画像検出器の製造方法は、以上のように、請求項7の構成に加えて、上記の第一および第二の工程では、上記の導電接続材および間隔保持材を、上記のアクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせ前における高さが該間隔保持材よりも該導電接続材の方が大きくなるようにパターン形成する構成である。

【0151】

それゆえ、請求項7の構成による効果に加えて、アクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせにおいて、両基板の間隔が間隔保持材の高さに達するまでプレスを行うことができる。よって、導電接続材が間隔保持材との高さの差だけ押しつぶされて、導電接続材を両基板に完全に密着させることができる。したがって、確実な導電接続を得ることができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施の形態に係る二次元画像検出器の全体構成の概略を示す断面図である。

【図2】

図1に示した二次元画像検出器の1画素当たりの構成（図1の領域A）を示す断面図である。

【図 3】

図 1 に示した二次元画像検出器の貼り合わせプロセスを示す説明図であり、図 3 (a) は導電接続材のパターン形成の工程、図 3 (b) は間隔保持材のパターン形成の工程、図 3 (c) はアクティブマトリクス基板と対向基板との位置合わせの工程、図 3 (d) はアクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせの工程を示す。

【図 4】

図 1 に示した二次元画像検出器の貼り合わせプロセスを示す説明図であり、図 4 (a) は基板の貼り合わせ前の導電接続材および間隔保持材、図 4 (b) は基板の貼り合わせ後の導電接続材および間隔保持材を示す。

【図 5】

図 1 に示した二次元画像検出器のアクティブマトリクス基板に形成されている各電極の配線パターンの一例を示す平面図である。

【図 6】

図 1 に示した二次元画像検出器のアクティブマトリクス基板に対する導電接続材および間隔保持材の配置関係を示す平面図である。

【図 7】

図 1 に示した二次元画像検出器の間隔保持材の一例を示す断面図である。

【図 8】

本発明の前提となる技術に係る二次元画像検出器の全体構成の概略を示す断面図である。

【図 9】

図 8 に示した二次元画像検出器の 1 画素当たりの構成（図 8 の領域 B）を示す断面図である。

【図 10】

従来の放射線二次元画像検出器の構成を示す斜視図である。

【図 11】

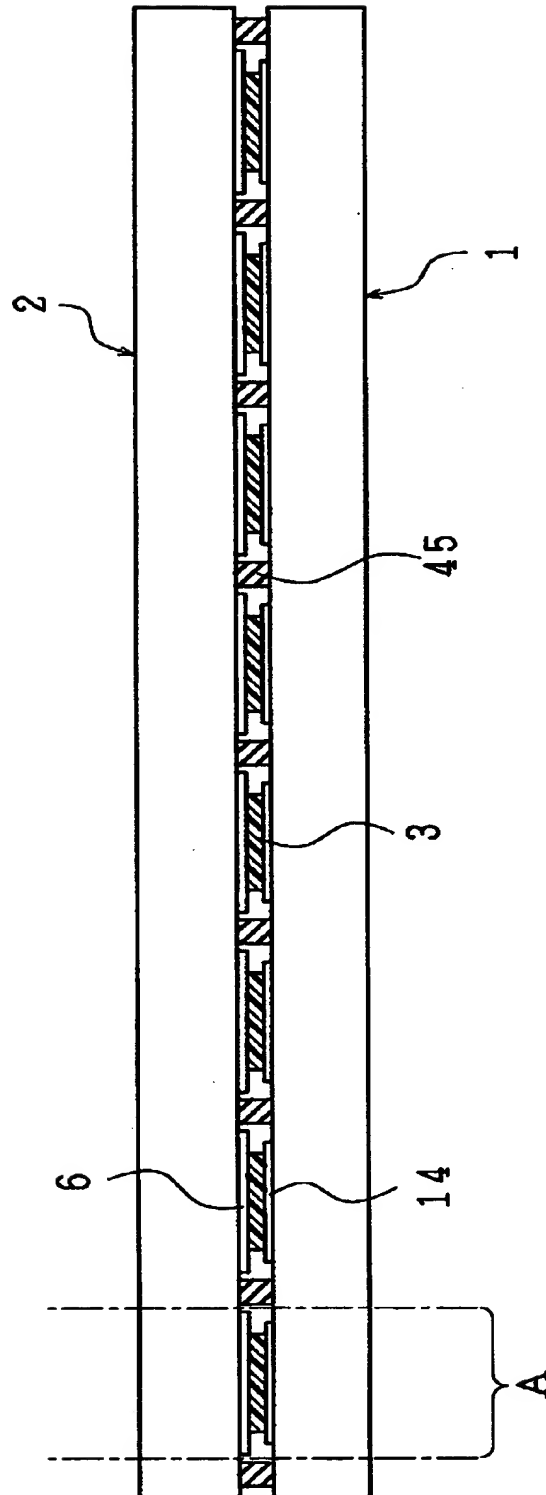
図 10 に示した従来の放射線二次元画像検出器の 1 画素当たりの構成を示す断面図である。

【符号の説明】

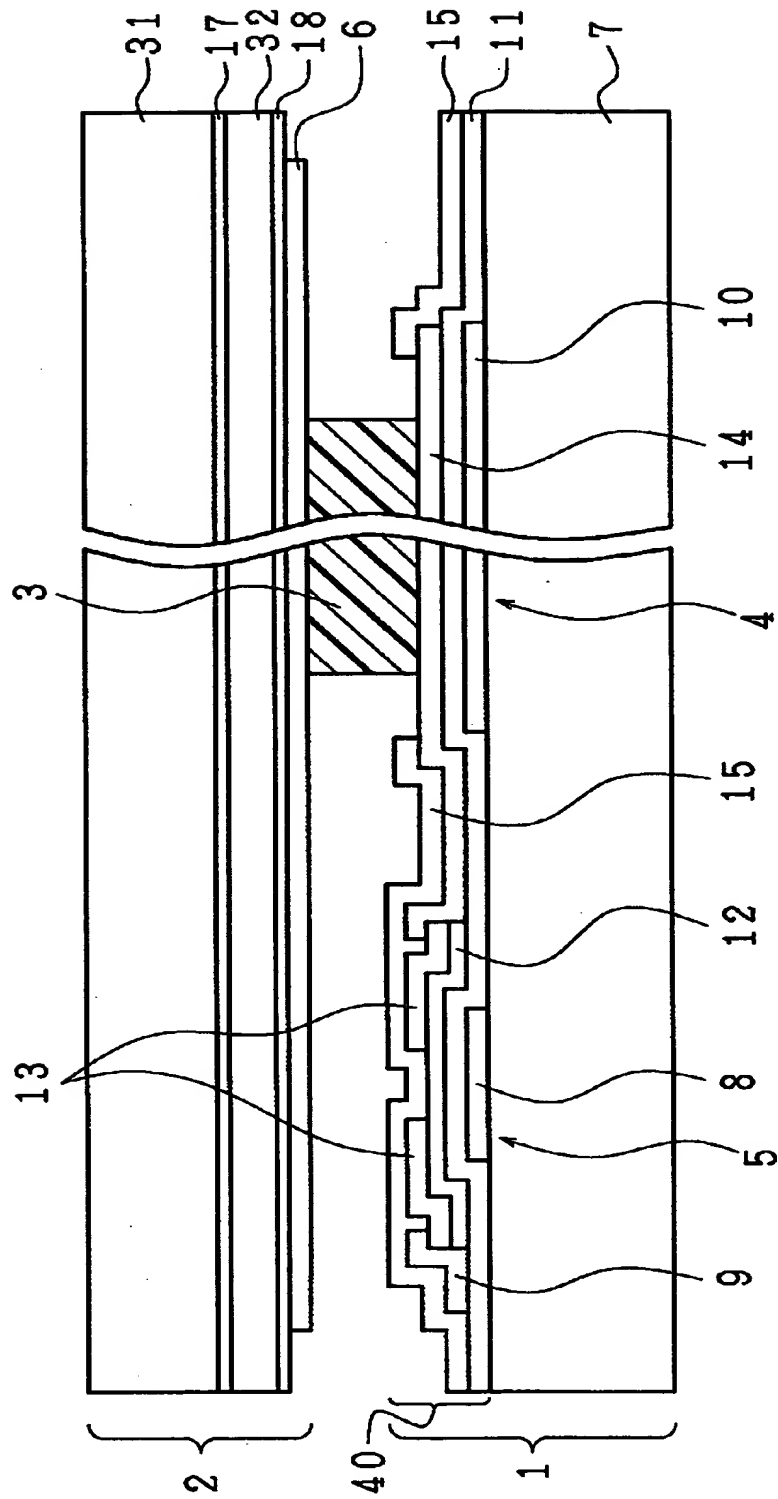
- 1 アクティブマトリクス基板
- 2 対向基板
- 3 導電接続材
- 5 TFT（スイッチング素子）
- 8 ゲート電極（電極配線）
- 9 ソース電極（電極配線）
- 14 画素電極
- 17 上部電極（電極部）
- 32 半導体層
- 40 画素配列層
- 45 間隔保持材
- 45a 樹脂材料
- 45b 補助材
- H2 基板の貼り合わせ前の導電接続材の高さ
- H1 基板の貼り合わせ前の間隔保持材の高さ

【書類名】 図面

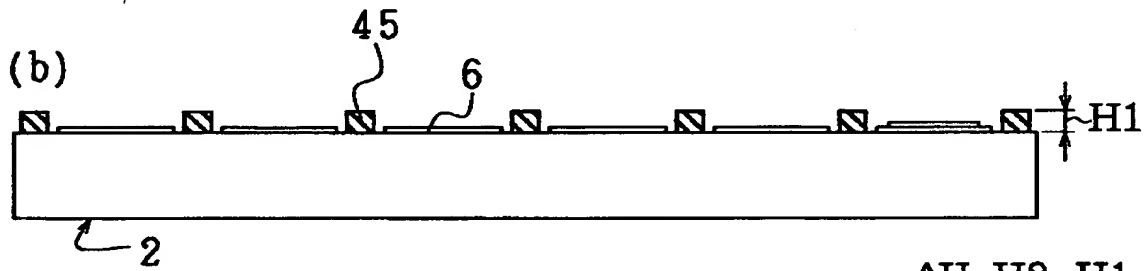
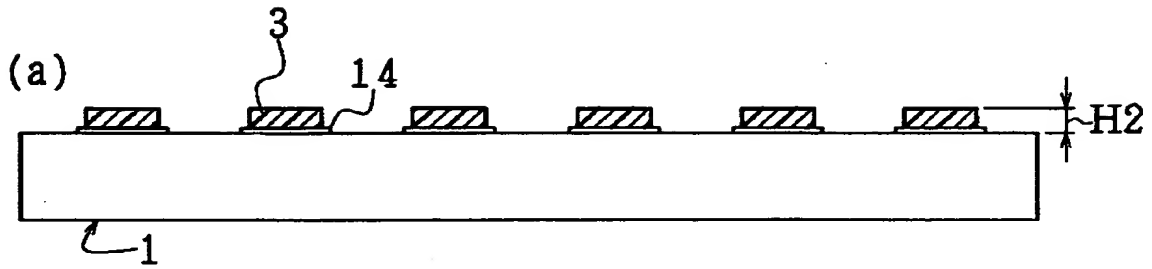
【図 1】



【図2】

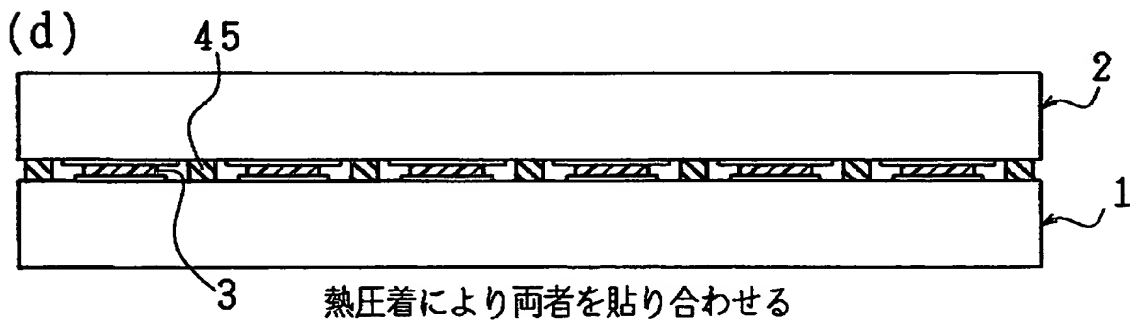
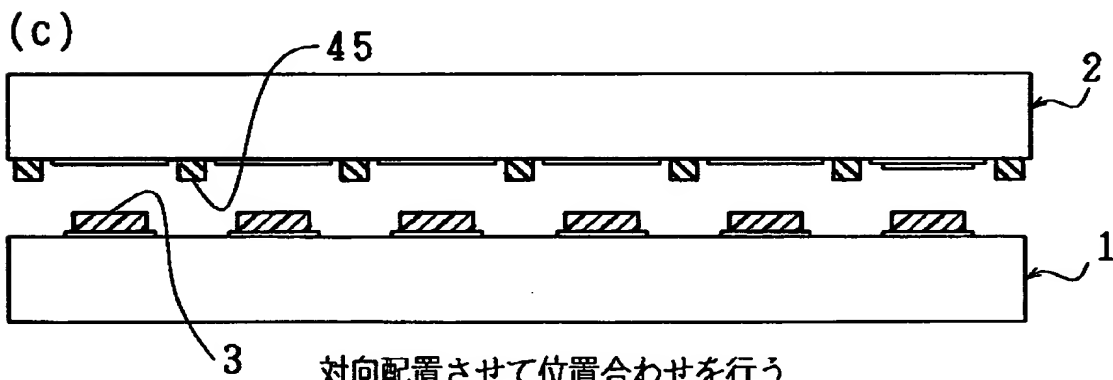


【図 3】



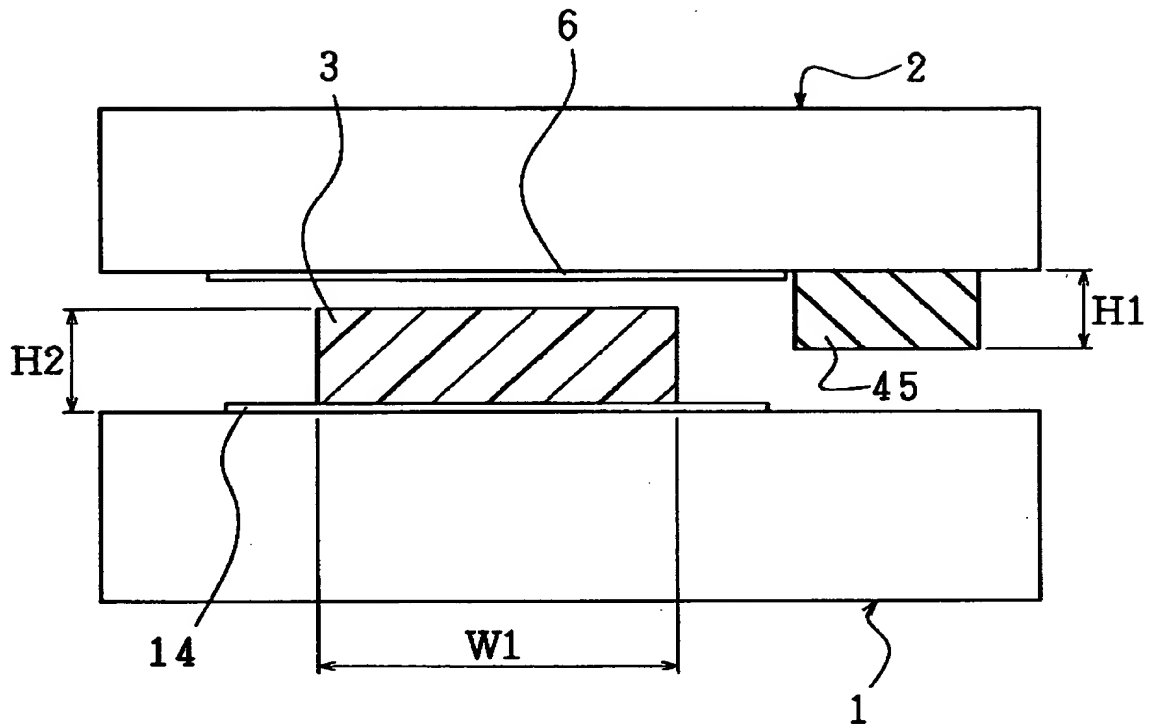
$$\Delta H = H2 - H1$$

各基板の上に導電接続材、間隔保持材をパターン形成する

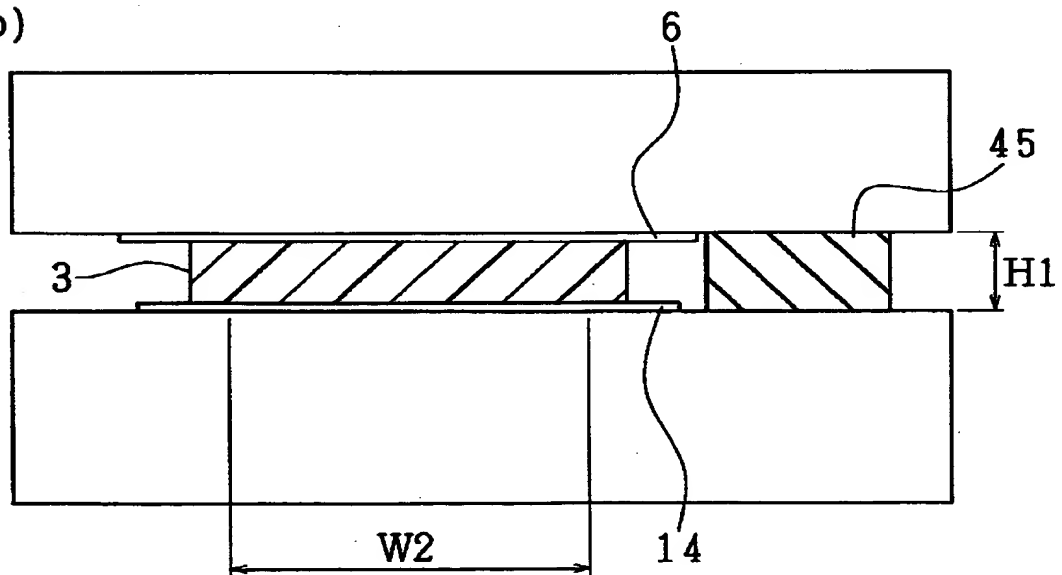


【図4】

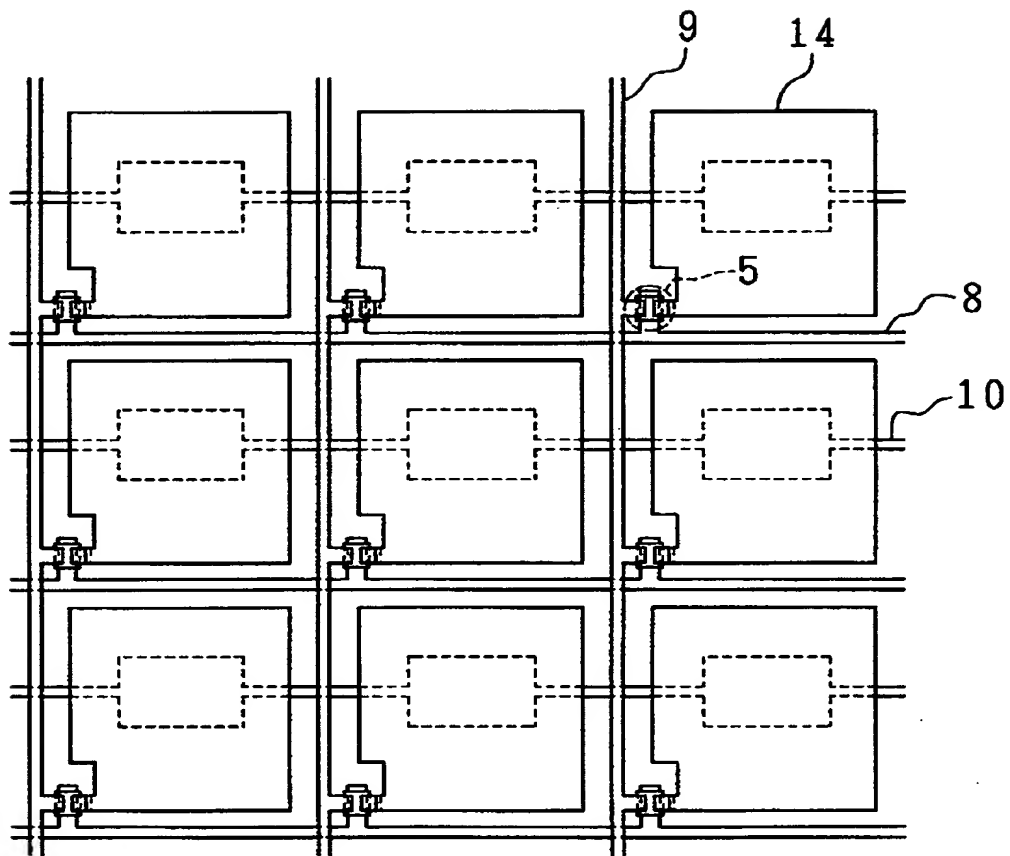
(a)



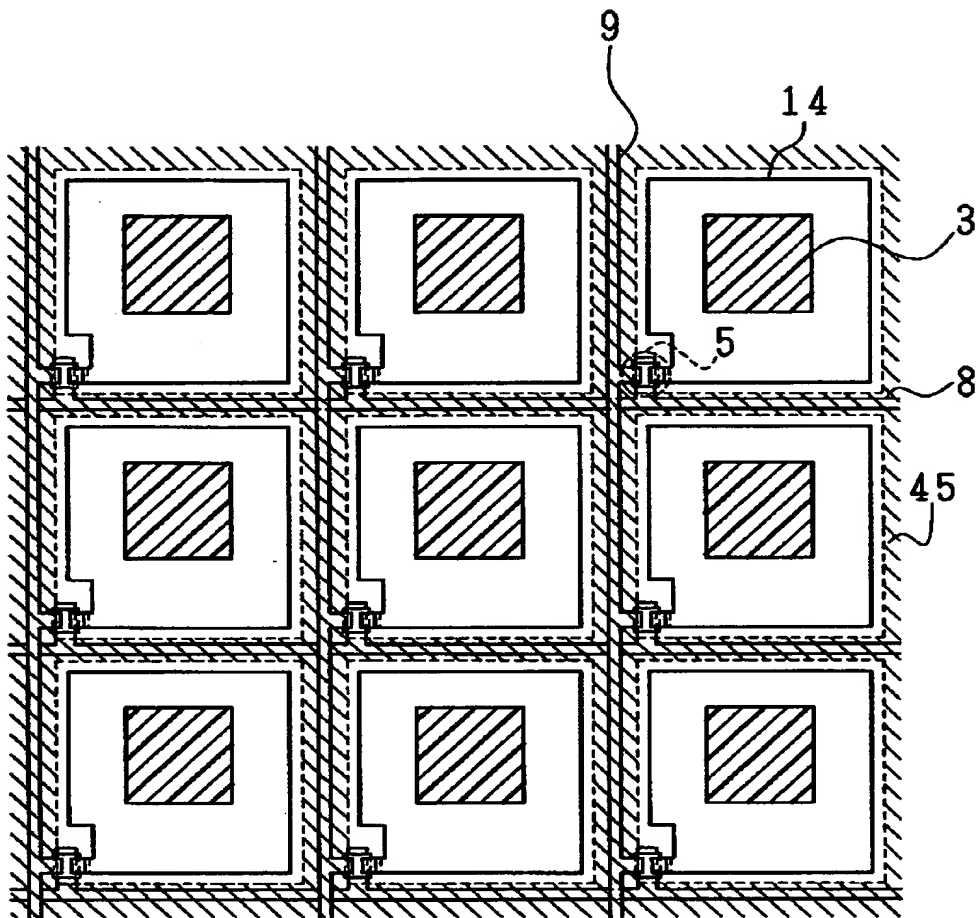
(b)



【図 5】

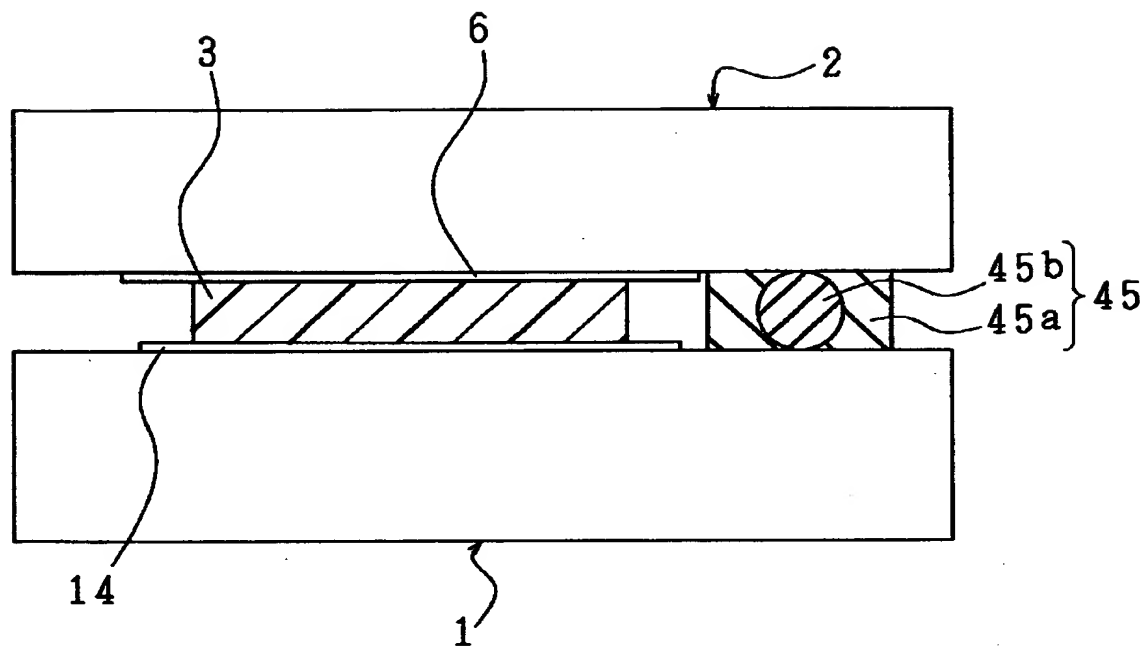


【図 6】

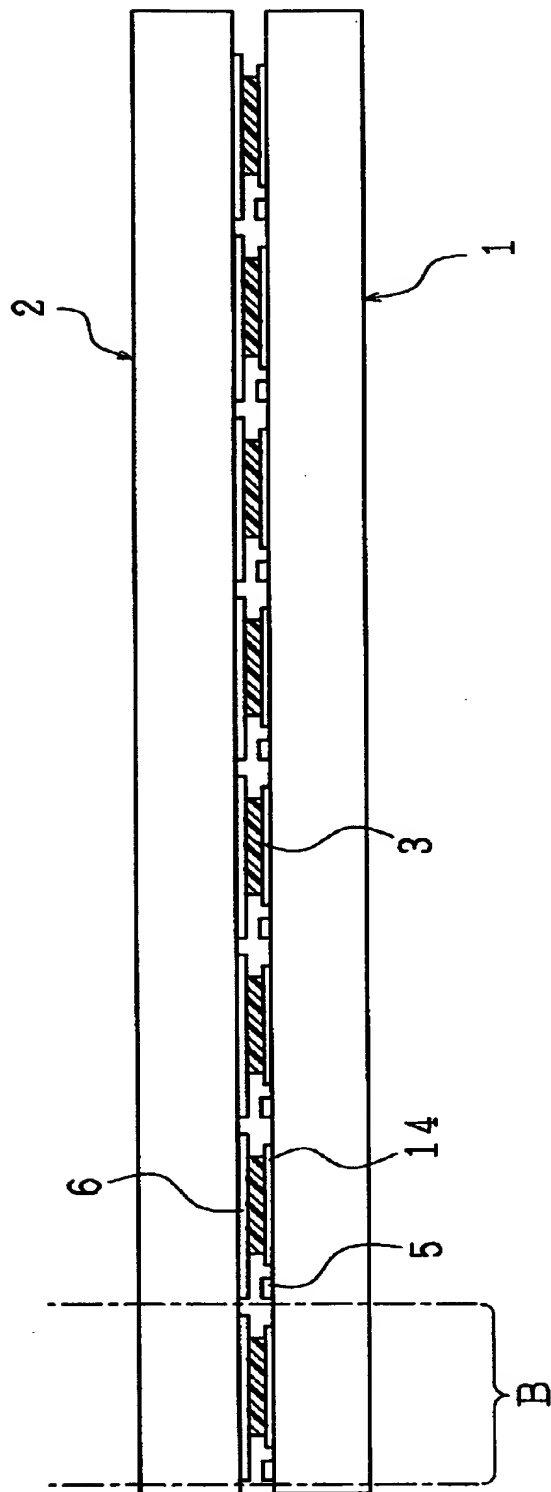


(Cs 電極 10 は省略)

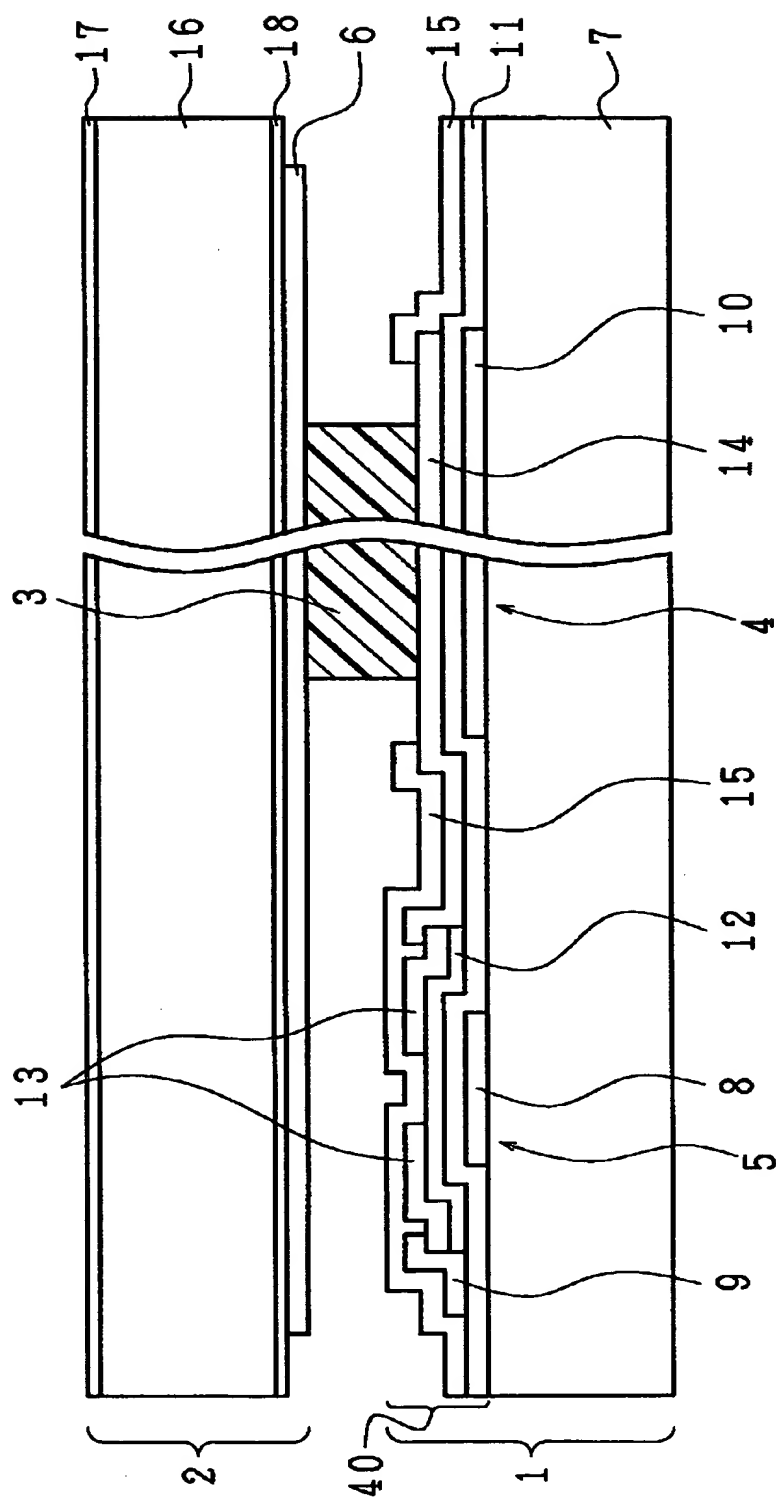
【図 7】



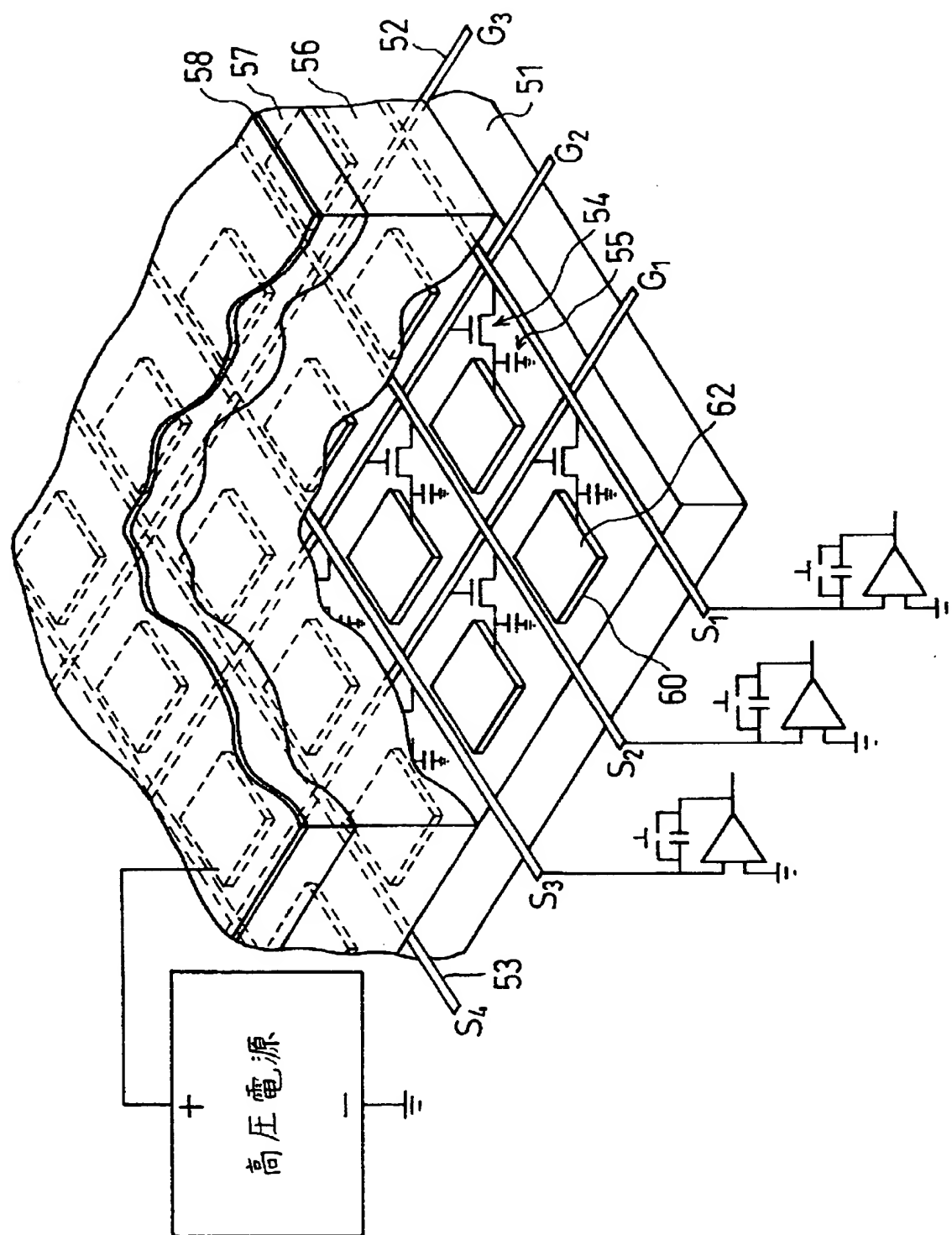
【図 8】



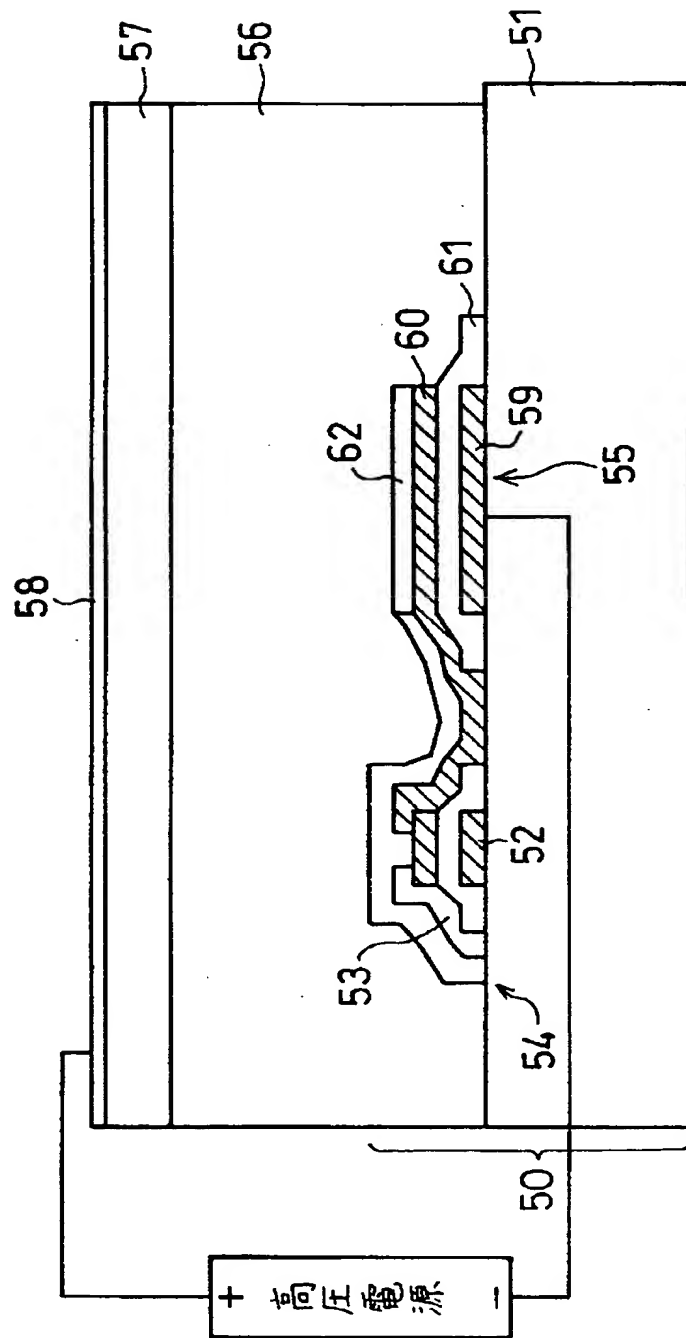
【図9】



【図 10】



【図 11】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 二次元画像検出器の応答性を改善し、動画像にも対応可能とする。あわせて、基板間隔を面内で均一にするとともに、両基板間の接続不良やリーク不良の発生を抑制する。

【解決手段】 二次元画像検出器は、画素電極 14 が形成されたアクティブマトリクス基板 1 と、電荷収集電極 6 が形成された対向基板 2 とが、画素電極 14 と電荷収集電極 6 とが対向して接続されるように、各画素ごとに独立して設けられた導電接続材 3 および間隔保持材 45 を介して貼り合わされている。さらに、間隔保持材 45 の樹脂材料 45a が軟質である場合には、樹脂材料 45a 中に電気絶縁性を有し、熱圧着による変形量の小さい補助材 45b を分散させておくことで、十分な間隔保持力を発揮することができる。

【選択図】 図 7

【書類名】 職権訂正データ
【訂正書類】 特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】
【識別番号】 000005049
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号
【氏名又は名称】 シャープ株式会社
【代理人】 申請人
【識別番号】 100080034
【住所又は居所】 大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目北 2 番 6 号 大和南
森町ビル 原謙三国際特許事務所
【氏名又は名称】 原 謙三

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005049]

1. 変更年月日	1990年 8月29日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
氏 名	シャープ株式会社